

# КТ815А, КТ815Б, КТ815В, КТ815Г

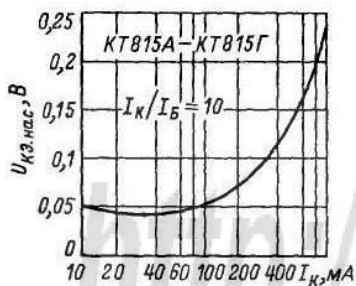
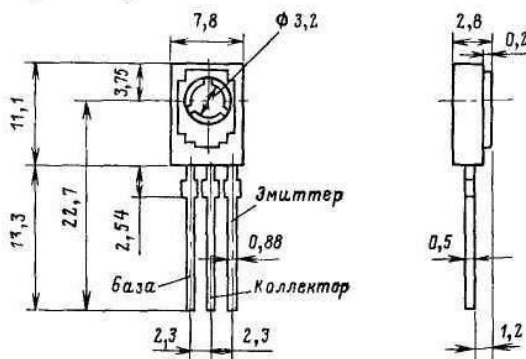
Транзисторы кремниевые меза-эпитаксиально-планарные *n-p-n* универсальные низкочастотные мощные.

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, операционных и дифференциальных усилителях, преобразователях, импульсных схемах.

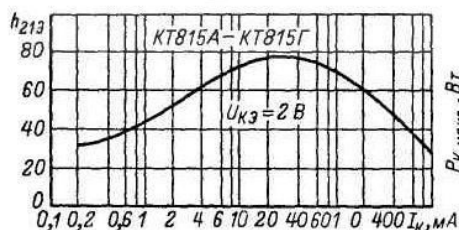
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами

Обозначение типа приводится на корпусе.

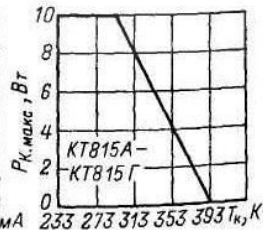
Масса транзистора не более 1 г



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора.



Зависимость максимально допустимой мощности рассеивания коллектора от температуры корпуса.

## Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_{Э} = 50$ мА, $\tau_n = 300$ мкс, $Q > 100$ не менее	
КТ815А . . . . .	25 В
КТ815Б . . . . .	40 В
КТ815В . . . . .	60 В
КТ815Г . . . . .	80 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 0,5$ А, $I_{Б} = 0,05$ А не более . . . . .	0,6 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{К} = 0,5$ А, $I_{Б} = 0,05$ А не более . . . . .	1,2 В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 2$ В, $I_{К} = 0,15$ А не менее	
при $T = 298$ К	
КТ815А, КТ815Б, КТ815В . . . . .	40
КТ815Г . . . . .	30
при $T = 233$ К	
КТ815А, КТ815Б, КТ815В . . . . .	30
КТ815Г . . . . .	20
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_{Э} = 0,03$ А не менее . . . . .	3 МГц
Емкость коллекторного перехода при $U_{КЭ} = 5$ В, $f = 465$ кГц не более . . . . .	60 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В не более . . . . .	75 пФ
Входное сопротивление в режиме малого сигнала при $U_{КЭ} = 5$ В, $I_{К} = 5$ мА, $f = 800$ Гц не менее . . . . .	800 Ом
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 40$ В не более	
при $T_{К} = 233 - 298$ К . . . . .	50 мкА
при $T_{К} = 373$ К . . . . .	1000 мкА

## Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 100$ Ом $T_{К} = 233 - 373$	
КТ815А . . . . .	40 В
КТ815Б . . . . .	50 В
КТ815В . . . . .	70 В
КТ815Г . . . . .	100 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер	
КТ815А . . . . .	25 В
КТ815Б . . . . .	40 В
КТ815В . . . . .	60 В
КТ815Г . . . . .	80 В
Постоянное напряжение база-эмиттер при $T_{К} = 213 - 373$ К . . . . .	5 В
Постоянный ток коллектора при $T_{К} = 233 - 373$ К . . . . .	1,5 А
Импульсный ток коллектора при $\tau_n \leq 10$ мс, $Q > 100$ , $T_{К} = 233 - 373$ К . . . . .	3 А
Постоянный ток базы при $T_{К} = 233 \div 373$ К . . . . .	0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
с теплоотводом при $T_{К} = 233 \div 298$ К . . . . .	10 Вт
без теплоотвода при $T = 233 \div 298$ К . . . . .	1 Вт
Температура перехода . . . . .	398 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 233 до $T_{К} = 373$ К

Примечания: 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода при  $T_{К} = 298 \div 373$  К снижается линейно на 0,01 Вт через 1 К.

2. Пайку выводов разрешается производить на расстоянии не менее 5 мм от корпуса. Разрешается производить пайку путем погружения выводов не более чем на 2 с в расплавленный припой с температурой не выше 523 К.

Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5-2 мм, при этом должны приниматься меры, исключающие возможность передачи усилий на корпус. Изгиб в плоскости выводов не допускается.